

快速實現記憶體測試與修復電路開發環境

START™ v3 含有 Hard-Repair 與 Soft-Repair 兩種記憶體修復技術，Hard-Repair 需要使用非揮發性記憶體 (NVM) 來當作記錄記憶體錯誤資訊的元件，可大幅縮短記憶體修復時間。而 Soft-Repair 可以不需要使用非揮發性記憶體 (NVM) 當作記錄記憶體缺陷資訊的元件，當有足夠備援記憶體時，Soft-Repair 可重複進行記憶體修復工程。

START™ v3 除了提供完整的記憶體測試與修復電路開發環境，還提供豐富的微架構，如：模組化設計微架構 (BUF)、低功耗設計微架構 (MCP)、自動插入時脈關閉電路元件微架構 (AGC)、上電後測試微架構 (POT)、動態記憶體測試微架構 (DMT)、根據版圖檔案進行記憶體分群微架構 (MGB)、記憶體資訊保護機制微架構 (MPM)、根據記憶體的功耗資訊自動進行記憶體分群微架構 (PCA)、錯誤更正碼 (ECC) 等微架構。

在車用電子晶片上，START™ v3 提供各種記憶體測試與修復解決方案，如 BIST & BISR + ECC：可以使車用電子晶片在系統運行中進行記憶體錯誤更正的行為。BIST & BISR + POT + RT：讓整體晶片上電後的記憶體測試時間能縮短又能兼顧確認記憶體測試的流程。BIST & BISR + POT + UDA：在晶片上電後執行定制化記憶體測試演算法，精準檢測出有記憶體缺陷的車用電子晶片，提高行車安全。BIST & BISR + POT + Repair：當車用電子晶片內的記憶體缺陷範圍過大時，透過 START™ v3 的記憶體修復技術，可以進行大範圍的記憶體修復，延長車用電子晶片的使用壽命與增加行車安全。

芯測科技的EDA工具START™ v3提供各種車用專屬解決方案，讓車用電子晶片不管在CP階段或是晶片運行階段，都可以符合高效能運算相關晶片的需求及ISO26262的規範。